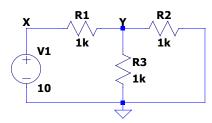


Symulator układów elektronicznych - zadania

1. Symulacja DC

- a. Punkt pracy (.op)
 - wykonaj schemat obwodu jak na rysunku (do nazywania połączeń wykorzystaj narzędzie Label Net)



- korzystając z dyrektywy .op wyznacz prądy płynące przez wszystkie elementy, potencjały wszystkich węzłów oraz rozpraszaną moc, zestawienie umieść w postaci tabeli w sprawozdaniu
- porównaj **napiecia** otrzymane w symulacji z obliczeniami analitycznymi.
- b. Symulacja wielopunktowa (.dc)
 - dla powyższego obwodu wykonaj symulację DC sweep dla liniowej zmiany napięcia źródła V1 od 10 do 100V
 - zaprezentuj na wspólnym wykresie napięcie V(X) oraz prąd I(R1), korzystając
 z kursorów określ wartość napięcia wejściowego dla której I(R1)= {nr_indeksu1/10}uA

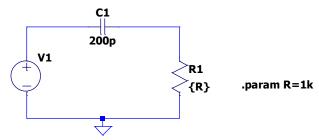
2. Określanie parametrów źródeł

- a. Zbuduj schemat obwodu jednooczkowego (połączenie szeregowe komponentu **voltage** oraz **res**)
 - połączenie pomiędzy źródłem a rezystorem nazwij A
 - ustaw wartość rezystancji na 1kOhm
 - ustaw parametry źródła napięcia tak, aby generowało przebieg **sinusoidalnie zmienny** o amplitudzie 5V i okresie równym {nr_indeksu2}ns
 - napisz wyrażenie na pomiar okresu korzystając z dyrektywy .meas
- b. Wykonaj symulację czasową (.tran) dla 3 okresów wymuszenia
 - przedstaw przebieg napięcia na rezystorze (w punkcie A)
 - zaprezentuj pomiar okresu przy pomocy kursorów
 - zamieść log symulacji z wynikiem działania dyrektywy .meas
- c. Powtórz operacje z punktów 2a-2b dla źródła **voltage** generującego przebieg **trójkątny** o identycznej amplitudzie i okresie równym {nr_indeksu3}us

3. Symulacja czasowa parametryczna

a. Zbuduj schemat obwodu jednooczkowego (połączenie szeregowe komponentów voltage cap oraz res)

M.Kropidłowski – v.1.1a



- połączenie pomiędzy kondensatorem a rezystorem nazwij B
- ustaw wartość rezystancji przy pomocy dyrektywy **.param** na 1kOhm
- ustaw parametry źródła napięcia tak, aby generowało przebieg **prostokątny** o napięciu 10V i częstotliwości 1MHz, wypełnienie ~50%, czasy narastania/opadania 2ns
- b. Wykonaj symulację czasową (.tran) dla 3 okresów wymuszenia z rozdzielczością 1ns
 - przedstaw wyniki symulacji na podwójnym wykresie (Plot Settings → Add Plot Pane)
 Pane1: przebieg napięcia wejściowego oraz spadek napięcia na kondensatorze
 Pane2: napięcie na rezystorze (w punkcie B) i prąd płynący przez rezystor
 - umieść na Pane1 charakterystykę V(B)/I(R1)
- c. Zdefiniuj ustawienia symulacji parametrycznej **.step** dla wykonania cyklu analiz czasowych:
 - ustaw zmienność parametru R w zakresie od 100hm do 2k0hm, 10 punktów na dekadę
 - zaprezentuj wszystkie cykle symulacji na wykresie jak w punkcie 3b, spróbuj wyjaśnić kształt prądu płynącego przez R1
- d. Zmień częstotliwość źródła V1 na {nr_indeksu1*10}**Hz** zachowując 50% wypełnienie przebiegu, powtórz symulację układu jak w punkcie 3c:
 - korzystając z selekcji wyników (Plot Settings → Select Step) wyszukaj i **określ wartość rezystancji**, dla której napięcie na C1 narasta do 90% V1 w czasie = 1/10 okresu przebiegu wejściowego (zaprezentuj ten przypadek w dokumentacji)

Przygotowanie danych do publikacji

Wszystkie schematy i przebiegi czasowe należy eksportować do formatu wektorowego (lub, w zależności od stosowanych narzędzi, drukować do PDF i importować rysunek PDF). Eksport do grafiki wektorowej: menu Tools →Write image to...

Wyniki publikowane jako zrzuty ekranu z oknem symulatora obniżają ocenę za wykonanie raportu.

Wyniki wykonania zadań, zawierające schematy wykonanych obwodów, charakterystyki oraz obliczenia, umieść w pliku PDF na stronie kursu (Symulator - sprawozdanie).

M.Kropidłowski – v.1.1a